

Preliminary datasheet

EasyPACK™ Modul mit CoolSiC™ Trench MOSFET und PressFIT / NTC

Eigenschaften

- Elektrische Eigenschaften
 - $V_{DSS} = 1200\text{ V}$
 - $I_{DN} = 50\text{ A} / I_{DRM} = 100\text{ A}$
 - Niederinduktives Design
 - Hohe Stromdichte
- Mechanische Eigenschaften
 - Integrierter NTC Temperatur Sensor
 - PressFIT Verbindungstechnik
 - Robuste Montage durch integrierte Befestigungsklammern



Typical appearance

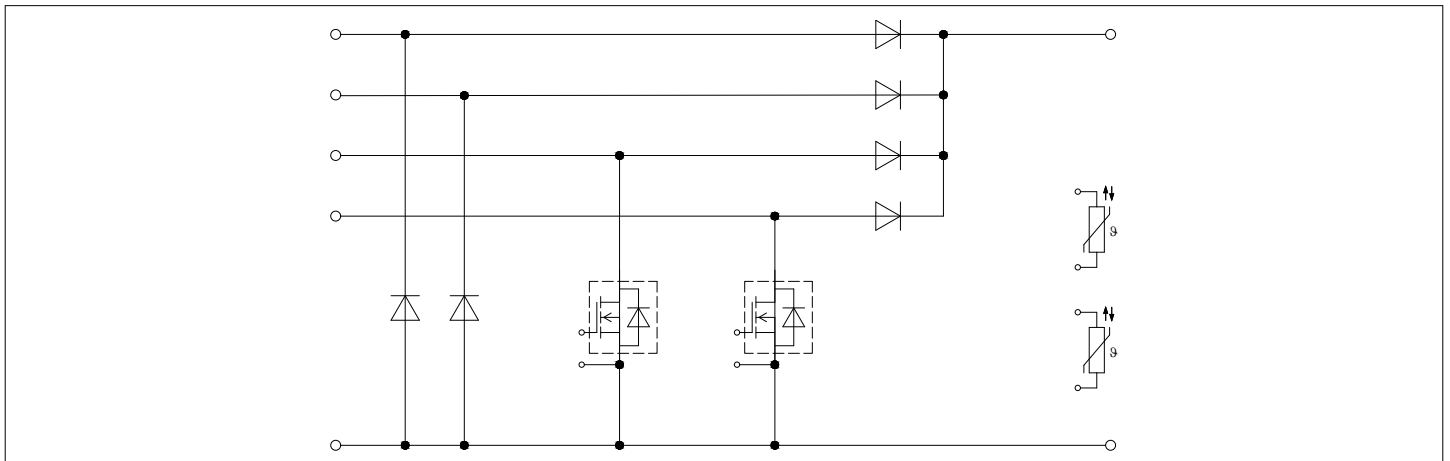
Potenzielle Anwendungen

- Solar Anwendungen

Produktvalidierung

- Qualifiziert für Industrieanwendungen entsprechend den relevanten Tests der IEC 60747, 60749 und 60068

Beschreibung



Inhalt

	Beschreibung	1
	Eigenschaften	1
	Potenzielle Anwendungen	1
	Produktvalidierung	1
	Inhalt	2
1	Gehäuse	3
2	MOSFET	3
3	Body diode	5
4	Diode, Hochsetzsteller	6
5	Bypass-Diode	6
6	Verpolschutz Diode	7
7	NTC-Widerstand	8
8	Kennlinien	9
9	Schaltplan	16
10	Gehäuseabmessungen	17
11	Modul-Label-Code	18
	Änderungshistorie	19
	Disclaimer	20

1 Gehäuse

Tabelle 1 Isolationskoordination

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Isolations-Prüfspannung	V_{ISOL}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $t = 1 \text{ min}$	3.0	kV
Innere Isolation		Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140)	Al_2O_3	
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	CTI		> 200	
Relativer Temperaturindex (elektr.)	RTI	Gehäuse	140	°C

Tabelle 2 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Modulstreuinduktivität	L_{sCE}			10		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{AA'+CC'}$	$T_H = 25 \text{ °C}$, pro Schalter		3		mΩ
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{CC'+EE'}$	$T_H = 25 \text{ °C}$, pro Schalter		2		mΩ
Lagertemperatur	T_{stg}		-40		125	°C
Anpresskraft für mech. Bef. pro Feder	F		20		50	N
Gewicht	G			24		g

Anmerkung: The current under continuous operation is limited to 25 A rms per connector pin.

2 MOSFET

Tabelle 3 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Drain-Source-Spannung	V_{DSS}	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	1200	V
Implementierter Drain-Strom	I_{DN}		50	A
Drain-Dauergleichstrom	I_{DDC}	$T_{vj} = 175 \text{ °C}$, $V_{GS} = 18 \text{ V}$ $T_H = 65 \text{ °C}$	45	A
Periodischer Drain-Spitzenstrom	I_{DRM}	verified by design, t_p limited by T_{vjmax}	100	A
Gate-source Spannung, max. transiente Spannung	V_{GS}	$D < 0.01$	-10/23	V
Gate-source Spannung, max. statische Spannung	V_{GS}		-7/20	V

Tabelle 4 Empfohlene Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Ein-Zustand Gate Spannung	$V_{GS(on)}$		15...18	V
Aus-Zustand Gate Spannung	$V_{GS(off)}$		-5...0	V

Tabelle 5 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.		
			Min	Typ	Max			
Einschaltwiderstand	$R_{DS(on)}$	$I_D = 50\text{ A}$		$V_{GS} = 18\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$	16.2		mΩ	
				$V_{GS} = 18\text{ V}, T_{vj} = 125\text{ °C}$		26.1		
				$V_{GS} = 18\text{ V}, T_{vj} = 175\text{ °C}$		34.7		
				$V_{GS} = 15\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$		19.4		
Gate-Schwellenspannung	$V_{GS(th)}$	$I_D = 20\text{ mA}, V_{DS} = V_{GS}, T_{vj} = 25\text{ °C},$ (tested after 1ms pulse at $V_{GS} = +20\text{ V}$)	3.45	4.3	5.15	V		
Gateladung	Q_G	$V_{DD} = 800\text{ V}, V_{GS} = -3/18\text{ V}$		0.149		μC		
Interner Gatewiderstand	R_{Gint}	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		4.1		Ω		
Eingangskapazität	C_{ISS}	$f = 100\text{ kHz}, V_{DS} = 800\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$		4.4		nF		
Ausgangskapazität	C_{OSS}	$f = 100\text{ kHz}, V_{DS} = 800\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$		0.21		nF		
Rückwirkungskapazität	C_{rSS}	$f = 100\text{ kHz}, V_{DS} = 800\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$		0.014		nF		
C_{OSS} Speicherenergie	E_{OSS}	$V_{DS} = 800\text{ V}, V_{GS} = -3/18\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$		86		μJ		
Drain-Source-Reststrom	I_{DSS}	$V_{DS} = 1200\text{ V}, V_{GS} = -3\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$		0.03	210	μA		
Gate-Source-Reststrom	I_{GSS}	$V_{DS} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$			400	nA		
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)	$t_{d on}$	$I_D = 50\text{ A}, R_{Gon} = 3.3\text{ Ω}, V_{DD} = 600\text{ V}, V_{GS} = -3/18\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		32		ns	
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$		32			
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$		32			
Anstiegszeit (induktive Last)	t_r	$I_D = 50\text{ A}, R_{Gon} = 3.3\text{ Ω}, V_{DD} = 600\text{ V}, V_{GS} = -3/18\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		23.9		ns	
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$		23.9			
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$		23.9			

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 5 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)	$t_{d\ off}$	$I_D = 50\ A, R_{Goff} = 2\ \Omega,$ $V_{DD} = 600\ V, V_{GS} = -3/18\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$	60.7		ns
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$	60.7		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$	60.7		
Fallzeit (induktive Last)	t_f	$I_D = 50\ A, R_{Goff} = 2\ \Omega,$ $V_{DD} = 600\ V, V_{GS} = -3/18\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$	10.5		ns
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$	10.5		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$	10.5		
Einschaltverlustenergie pro Puls	E_{on}	$I_D = 50\ A, V_{DD} = 600\ V,$ $L_\sigma = 35\ nH, V_{GS} = -3/18\ V,$ $R_{Gon} = 3.3\ \Omega, di/dt = 4.29$ $kA/\mu s (T_{vj} = 175\ ^\circ C)$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$	0.516		mJ
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$	0.516		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$	0.516		
Abschaltverlustenergie pro Puls	E_{off}	$I_D = 50\ A, V_{DD} = 600\ V,$ $L_\sigma = 35\ nH, V_{GS} = -3/18\ V,$ $R_{Goff} = 2\ \Omega, dv/dt = 45.7$ $kV/\mu s (T_{vj} = 175\ ^\circ C)$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$	0.133		mJ
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$	0.133		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$	0.133		
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro MOSFET		1.1		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\ op}$		-40		175	$^\circ C$

Anmerkung: The selection of positive and negative gate-source voltages impacts losses and the long-term behavior of the MOSFET and body diode. The design guidelines described in Application Notes AN 2018-09 and AN 2021-13 must be considered to ensure sound operation of the device over the planned lifetime.

$T_{vj,op} > 150^\circ C$ is allowed for operation at overload conditions for MOSFET and body diode. For detailed specifications, please refer to AN 2021-13.

3 Body diode

Tabelle 6 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Body Diode-Gleichstrom	I_{SD}	$T_{vj} = 175\ ^\circ C, V_{GS} = -3\ V$ $T_H = 65\ ^\circ C$	24	A

Tabelle 7 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.	
			Min	Typ	Max		
Durchlassspannung	V_{SD}	$I_{SD} = 50\ A, V_{GS} = -3\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		4.2	5.35	V
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		3.9		
			$T_{vj} = 175\ ^\circ C$		3.8		

4 Diode, Hochsetzsteller

Tabelle 8 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte		Einh.
			Min	Typ	
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		1200	V
Dauergleichstrom	I_F			40	A
Periodischer Spitzenstrom	I_{FRM}	$t_p = 1\text{ ms}$		80	A
Grenzlastintegral	I^2t	$t_p = 10\text{ ms}, V_R = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 125\text{ °C}$	320	A^2s
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	295	

Tabelle 9 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Durchlassspannung	V_F	$I_F = 40\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1.40	1.85	V
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	1.70		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	1.85		
Rückstromspitze	I_{RM}	$V_{CC} = 600\text{ V}, I_F = 40\text{ A},$ $-di_F/dt = 3900\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150\text{ °C}$)	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	43		A
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	43		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	43		
Sperrverzögerungsladung	Q_r	$V_{CC} = 600\text{ V}, I_F = 40\text{ A},$ $-di_F/dt = 3900\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150\text{ °C}$)	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	4.03		μC
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	4.03		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	4.03		
Abschaltenergie pro Puls	E_{rec}	$V_{CC} = 600\text{ V}, I_F = 40\text{ A},$ $-di_F/dt = 3900\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150\text{ °C}$)	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	0.063		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	0.063		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	0.063		
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro Diode		1.11		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\text{ op}}$		-40		150	$^{\circ}\text{C}$

5 Bypass-Diode

Tabelle 10 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte		Einh.
			Min	Typ	
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		1200	V
Durchlassstrom Grenzeffektivwert pro Chip	I_{FRMSM}	$T_H = 80\text{ °C}$		50	A

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 10 (Fortsetzung) Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.	
Gleichrichter Ausgang Grenzeffektivstrom	I_{RMSM}	$T_H = 80\text{ °C}$	50	A	
Stoßstrom Grenzwert	I_{FSM}	$t_p = 10\text{ ms}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	450	A
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	360	
Grenzlastintegral	I^2t	$t_p = 10\text{ ms}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1010	A ² s
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	648	

Tabelle 11 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Durchlassspannung	V_F	$I_F = 30\text{ A}$ $T_{vj} = 150\text{ °C}$		0.95		V
Sperrstrom	I_r	$T_{vj} = 150\text{ °C}$, $V_R = 1200\text{ V}$		0.1		mA
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro Diode		1.29		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj,op}$		-40		150	°C

6 Verpolschutz Diode

Tabelle 12 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.	
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1200	V	
Durchlassstrom Grenzeffektivwert pro Chip	I_{FRMSM}	$T_H = 80\text{ °C}$	50	A	
Gleichrichter Ausgang Grenzeffektivstrom	I_{RMSM}	$T_H = 80\text{ °C}$	50	A	
Stoßstrom Grenzwert	I_{FSM}	$t_p = 10\text{ ms}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	450	A
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	360	
Grenzlastintegral	I^2t	$t_p = 10\text{ ms}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1010	A ² s
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	648	

Tabelle 13 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Durchlassspannung	V_F	$I_F = 30\text{ A}$ $T_{vj} = 150\text{ °C}$		0.95		V
Sperrstrom	I_r	$T_{vj} = 150\text{ °C}$, $V_R = 1200\text{ V}$		0.1		mA

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 13 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro Diode		1.16		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj, op}$		-40		150	°C

7 NTC-Widerstand

Tabelle 14 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Nennwiderstand	R_{25}	$T_{NTC} = 25\text{ °C}$		5		kΩ
Abweichung von R_{100}	$\Delta R/R$	$T_{NTC} = 100\text{ °C}, R_{100} = 493\text{ Ω}$	-5		5	%
Verlustleistung	P_{25}	$T_{NTC} = 25\text{ °C}$			20	mW
B-Wert	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		3375		K
B-Wert	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		3411		K
B-Wert	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		3433		K

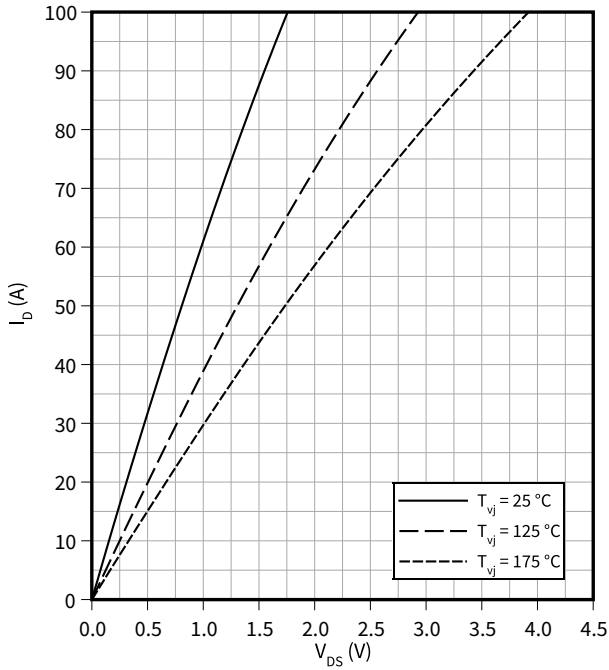
Anmerkung: Angaben gemäß gültiger Application Note.

8 Kennlinien

Ausgangskennlinie (typisch), MOSFET

$$I_D = f(V_{DS})$$

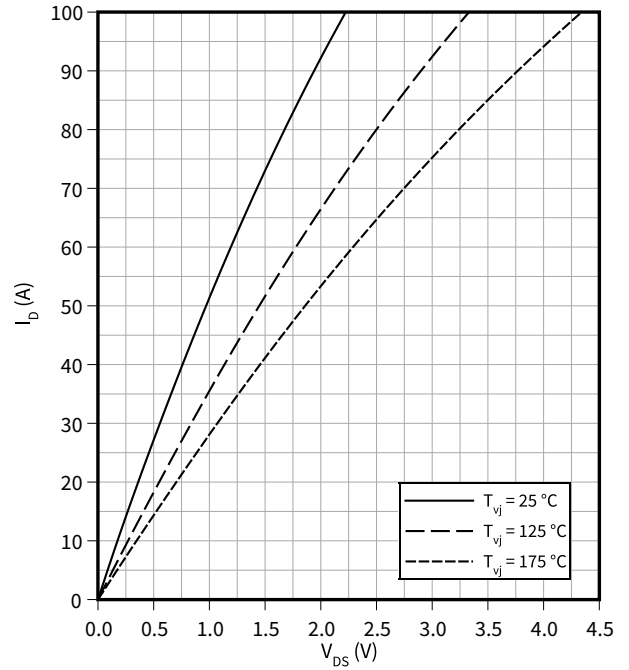
$$V_{GS} = 18 \text{ V}$$



Ausgangskennlinie (typisch), MOSFET

$$I_D = f(V_{DS})$$

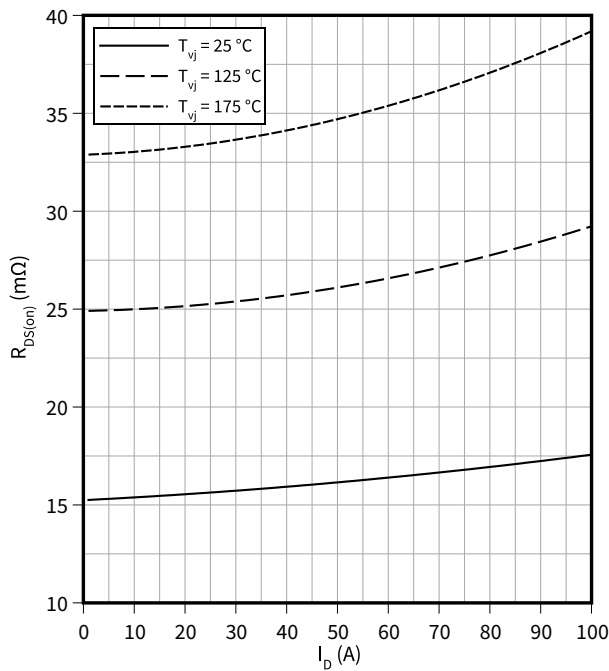
$$V_{GS} = 15 \text{ V}$$



Einschaltwiderstand (typisch), MOSFET

$$R_{DS(on)} = f(I_D)$$

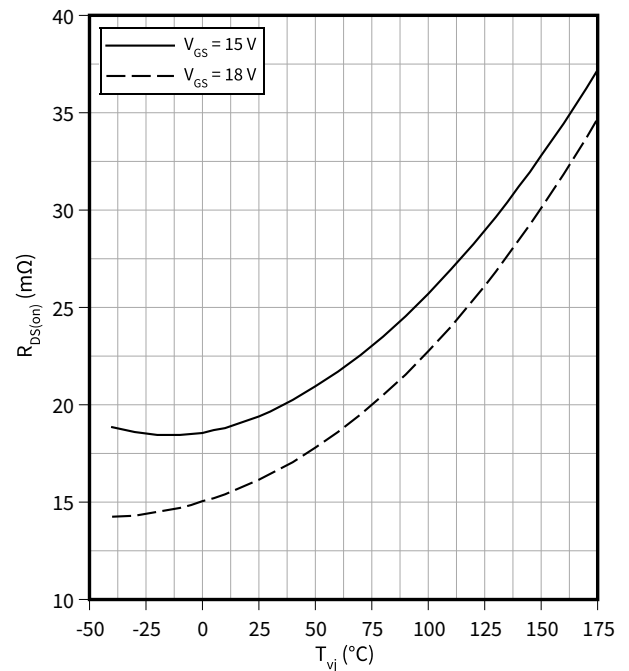
$$V_{GS} = 18 \text{ V}$$



Einschaltwiderstand (typisch), MOSFET

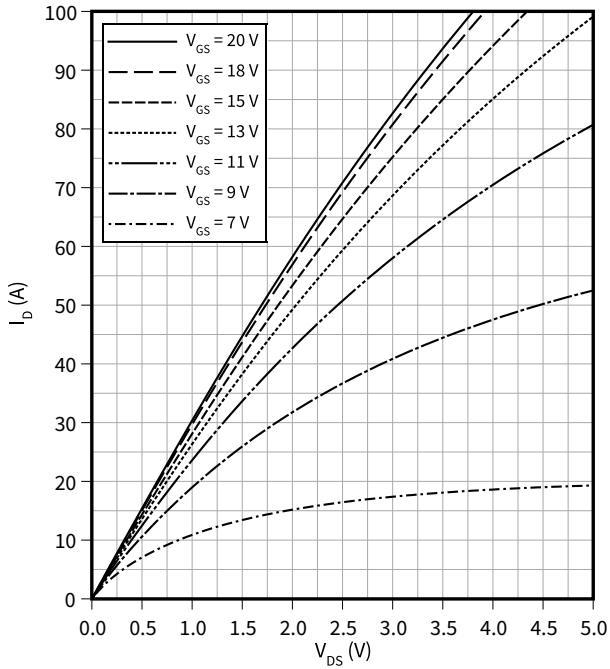
$$R_{DS(on)} = f(T_{vj})$$

$$I_D = 50 \text{ A}$$



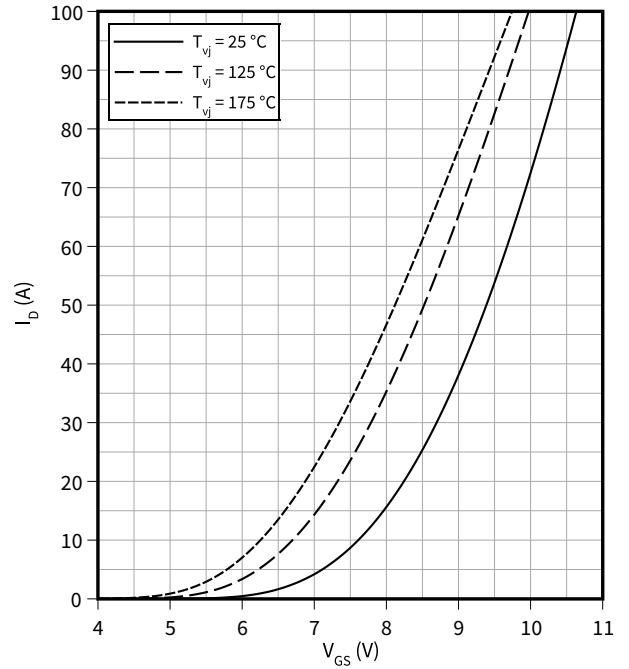
Ausgangskennlinienfeld (typisch), MOSFET

$I_D = f(V_{DS})$
 $T_{vj} = 175\text{ °C}$



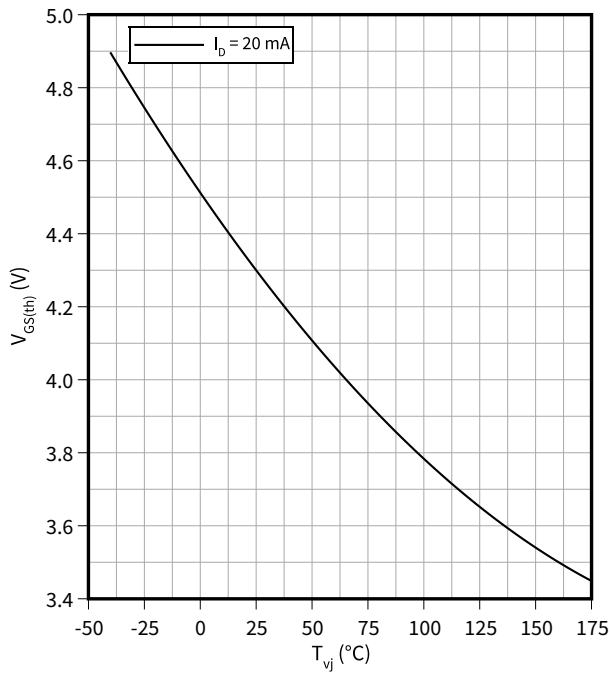
Übertragungscharakteristik (typisch), MOSFET

$I_D = f(V_{GS})$
 $V_{DS} = 20\text{ V}$



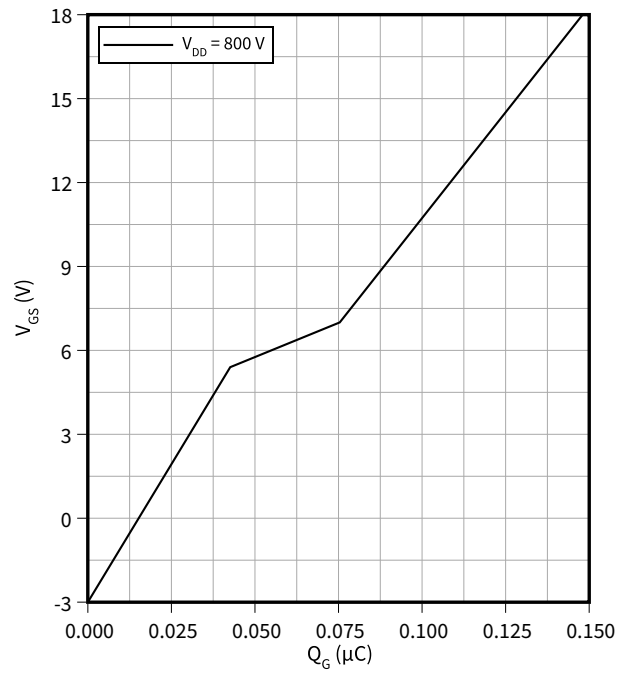
Gate-Source Schwellspannung (typisch), MOSFET

$V_{GS(th)} = f(T_{vj})$
 $V_{GS} = V_{DS}$



Gateladungs Charakteristik (typisch), MOSFET

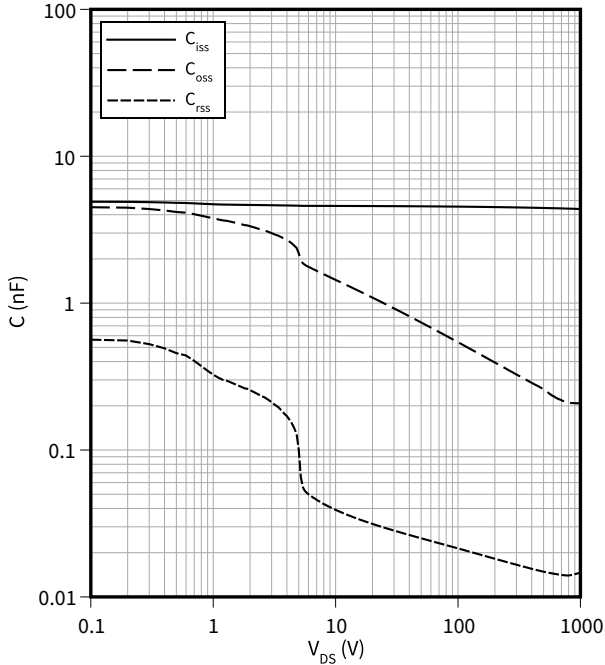
$V_{GS} = f(Q_G)$
 $I_D = 50\text{ A}, T_{vj} = 25\text{ °C}$



Kapazitäts Charakteristik (typisch), MOSFET

$C = f(V_{DS})$

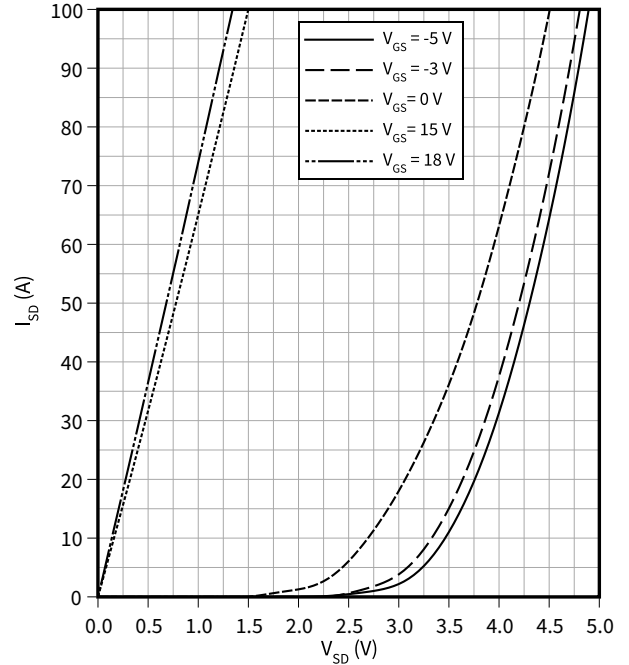
$f = 100 \text{ kHz}, T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}, V_{GS} = 0 \text{ V}$



Durchlasskennlinie der Body-Diode (typisch), MOSFET

$I_{SD} = f(V_{SD})$

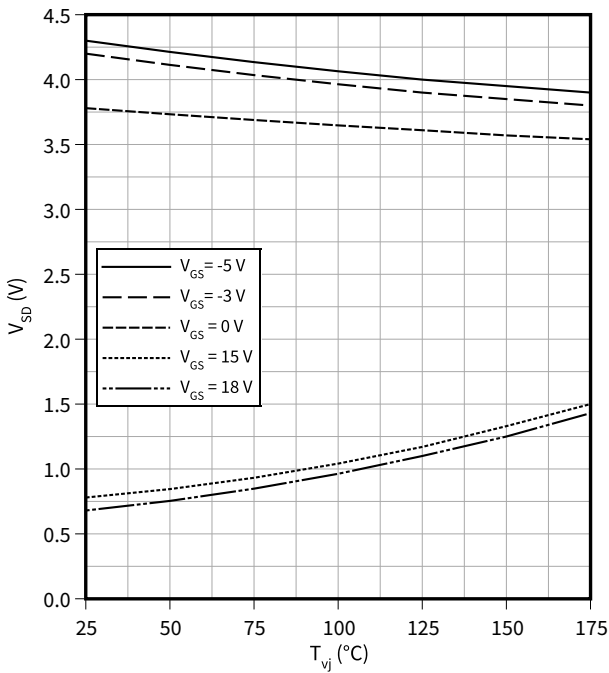
$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$



Durchlasskennlinie der Body-Diode (typisch), MOSFET

$V_{SD} = f(T_{vj})$

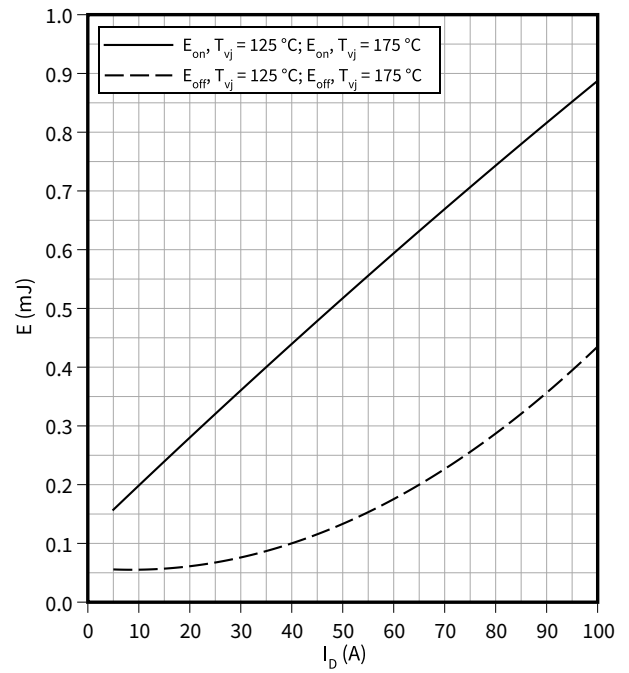
$I_{SD} = 50 \text{ A}$



Schaltverluste (typisch), MOSFET

$E = f(I_D)$

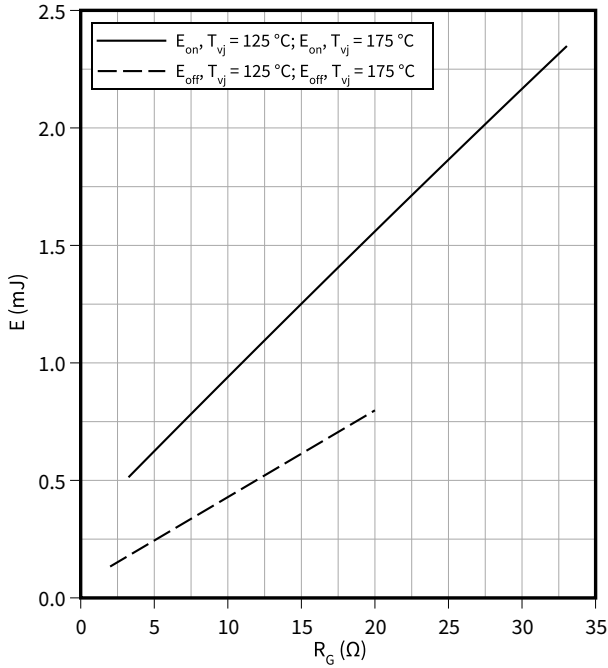
$R_{Goff} = 2 \text{ } \Omega, R_{Gon} = 3.3 \text{ } \Omega, V_{DD} = 600 \text{ V}, V_{GS} = -3/18 \text{ V}$



Schaltverluste (typisch), MOSFET

$E = f(R_G)$

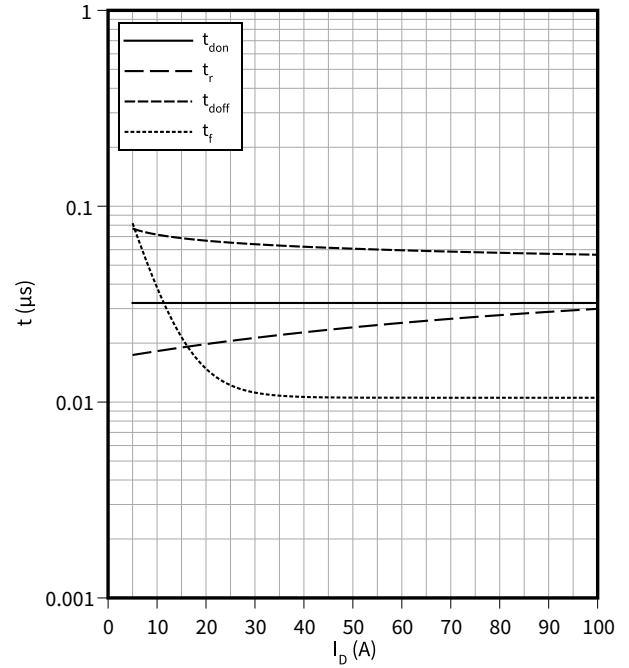
$V_{DD} = 600 \text{ V}, I_D = 50 \text{ A}, V_{GS} = -3/18 \text{ V}$



Schaltzeiten (typisch), MOSFET

$t = f(I_D)$

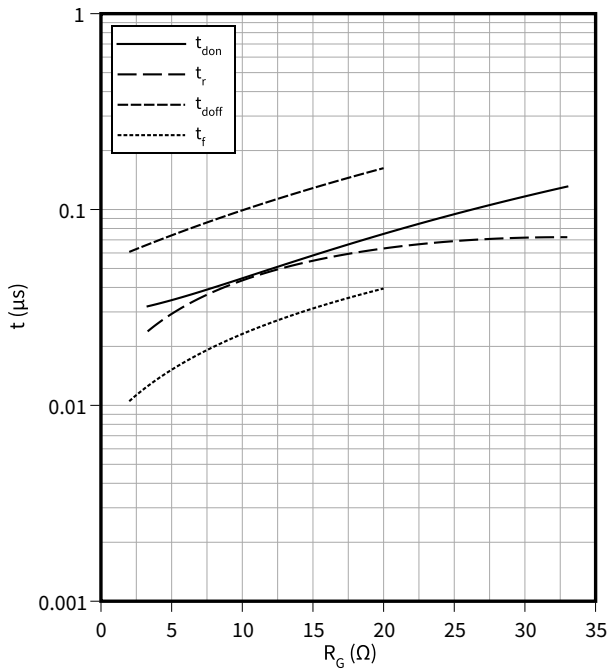
$R_{Goff} = 2 \text{ } \Omega, R_{Gon} = 3.3 \text{ } \Omega, V_{DD} = 600 \text{ V}, T_{vj} = 175 \text{ } ^\circ\text{C}, V_{GS} = -3/18 \text{ V}$



Schaltzeiten (typisch), MOSFET

$t = f(R_G)$

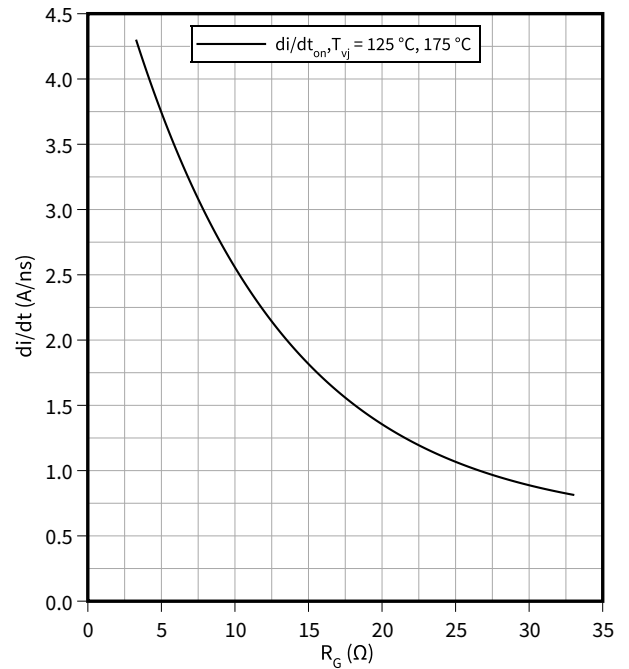
$V_{DD} = 600 \text{ V}, I_D = 50 \text{ A}, T_{vj} = 175 \text{ } ^\circ\text{C}, V_{GS} = -3/18 \text{ V}$



Stromsteilheit (typisch), MOSFET

$di/dt = f(R_G)$

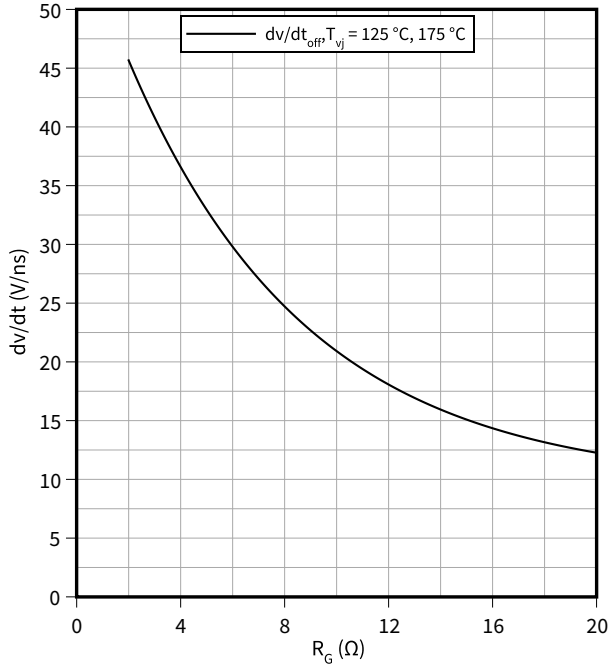
$V_{DD} = 600 \text{ V}, I_D = 50 \text{ A}, V_{GS} = -3/18 \text{ V}$



Spannungssteilheit (typisch), MOSFET

$dv/dt = f(R_G)$

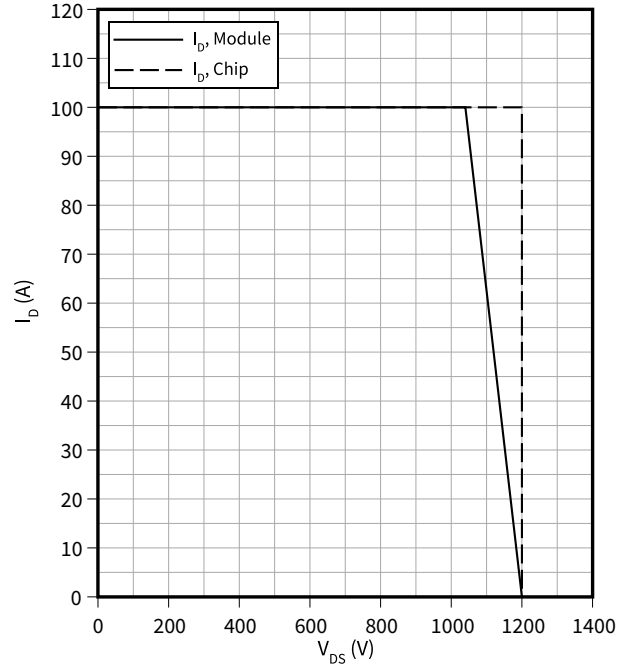
$V_{DD} = 600\text{ V}, I_D = 50\text{ A}, V_{GS} = -3/18\text{ V}$



Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich (RBSOA), MOSFET

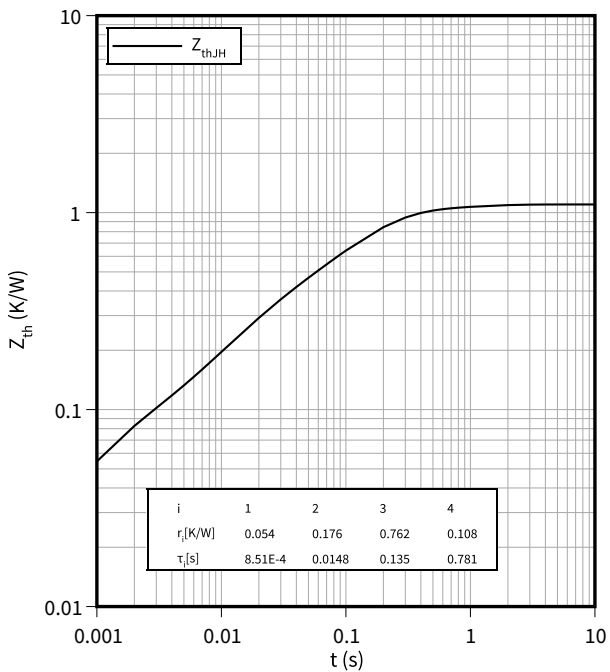
$I_D = f(V_{DS})$

$R_{Goff} = 2\ \Omega, T_{vj} = 175\ \text{°C}, V_{GS} = -3/18\ \text{V}$



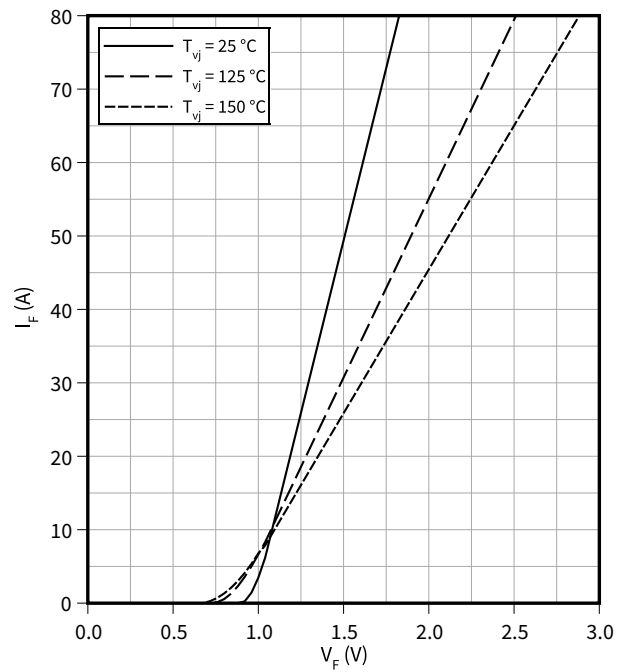
Transienter Wärmewiderstand , MOSFET

$Z_{th} = f(t)$



Durchlasskennlinie (typisch), Diode, Hochsetzsteller

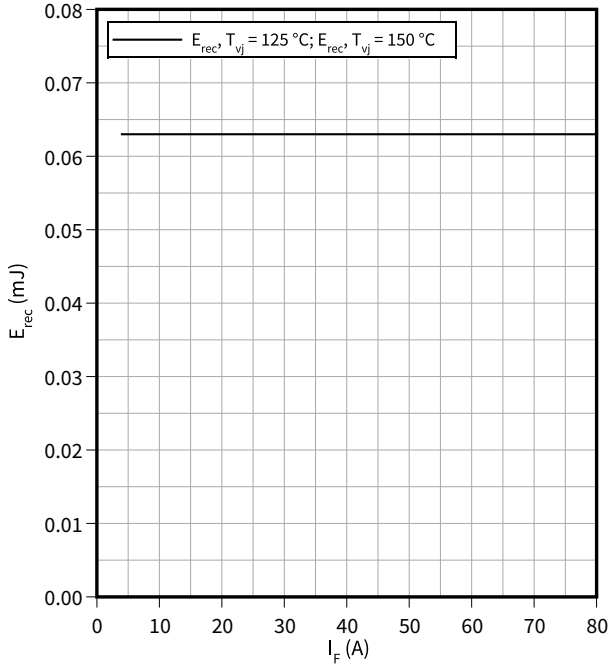
$I_F = f(V_F)$



Schaltverluste (typisch), Diode, Hochsetzsteller

$E_{rec} = f(I_F)$

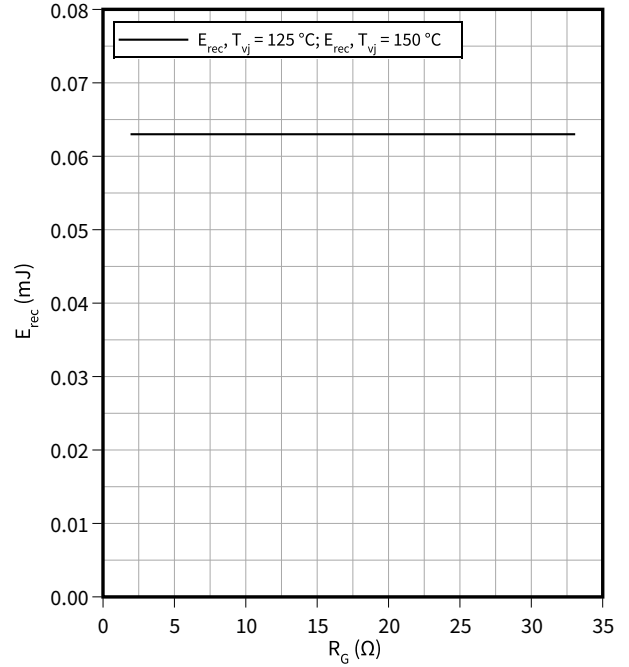
$R_{Gon} = 3.3 \Omega, V_{CC} = 600 V$



Schaltverluste (typisch), Diode, Hochsetzsteller

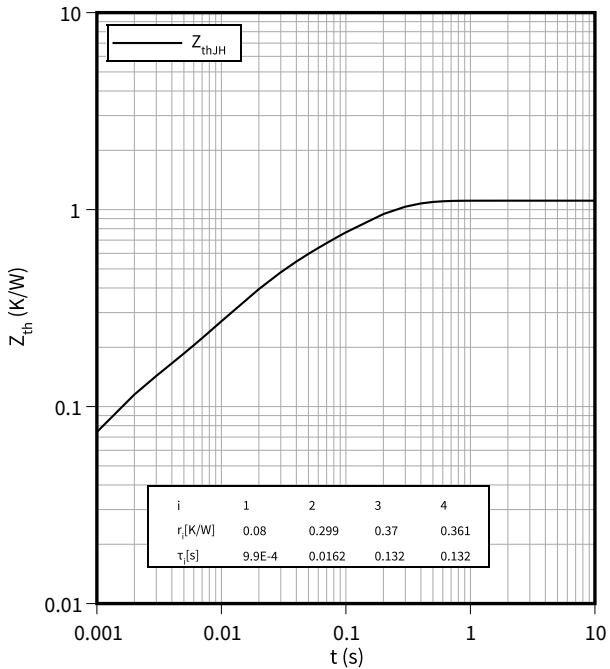
$E_{rec} = f(R_G)$

$I_F = 40 A, V_{CC} = 600 V$



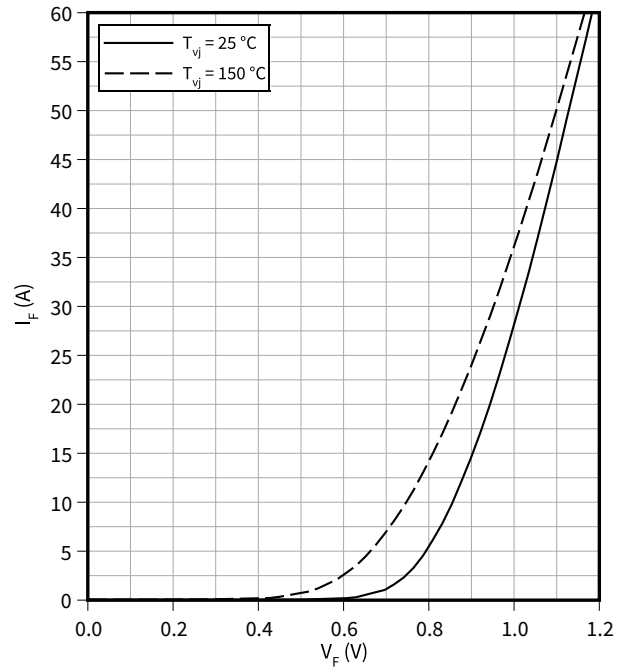
Transienter Wärmewiderstand, Diode, Hochsetzsteller

$Z_{th} = f(t)$



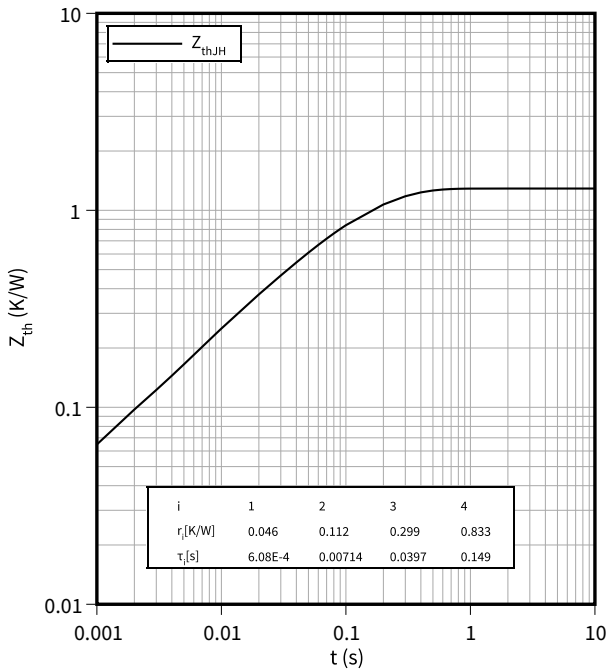
Durchlasskennlinie (typisch), Bypass-Diode

$I_F = f(V_F)$



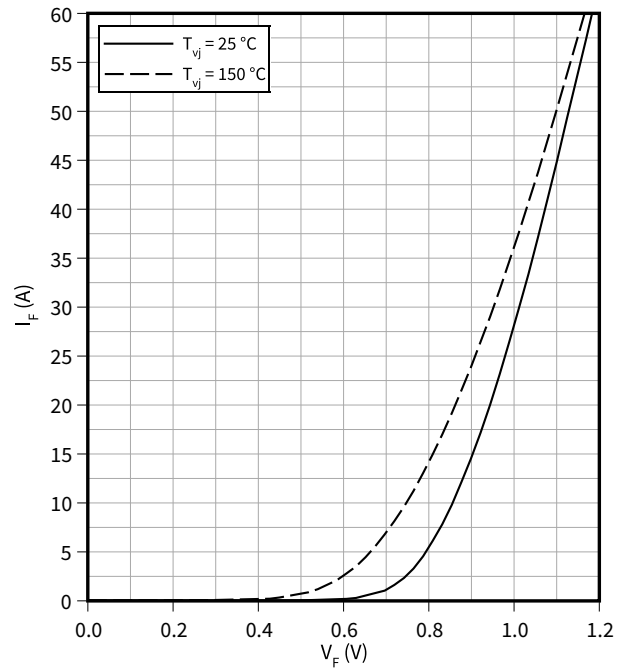
Transienter Wärmewiderstand, Bypass-Diode

$Z_{th} = f(t)$



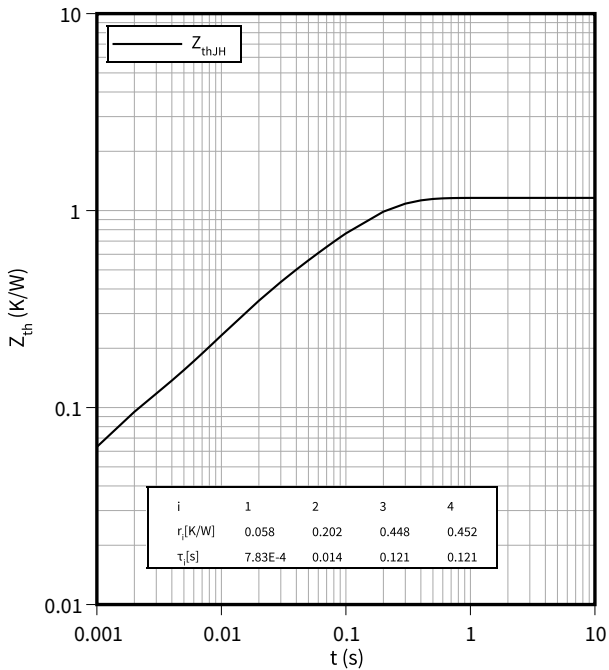
Durchlasskennlinie (typisch), Verpolschutz Diode

$I_F = f(V_F)$



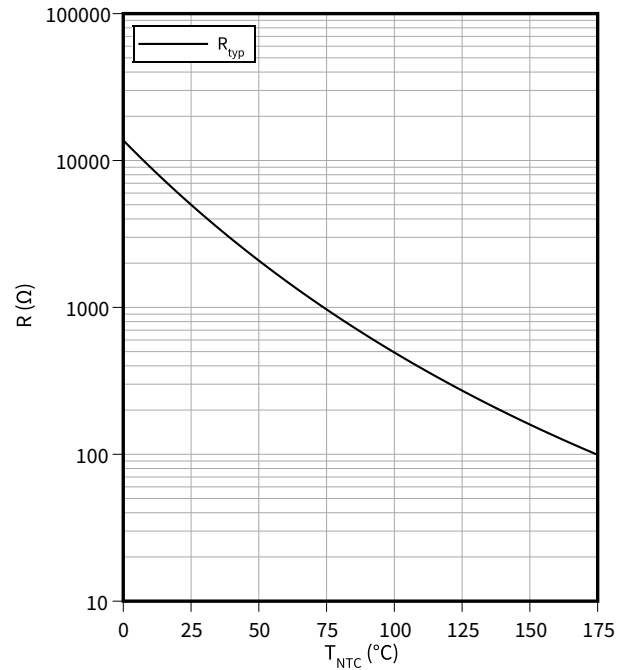
Transienter Wärmewiderstand, Verpolschutz Diode

$Z_{th} = f(t)$



Temperaturkennlinie (typisch), NTC-Widerstand

$R = f(T_{NTC})$



9 Schaltplan

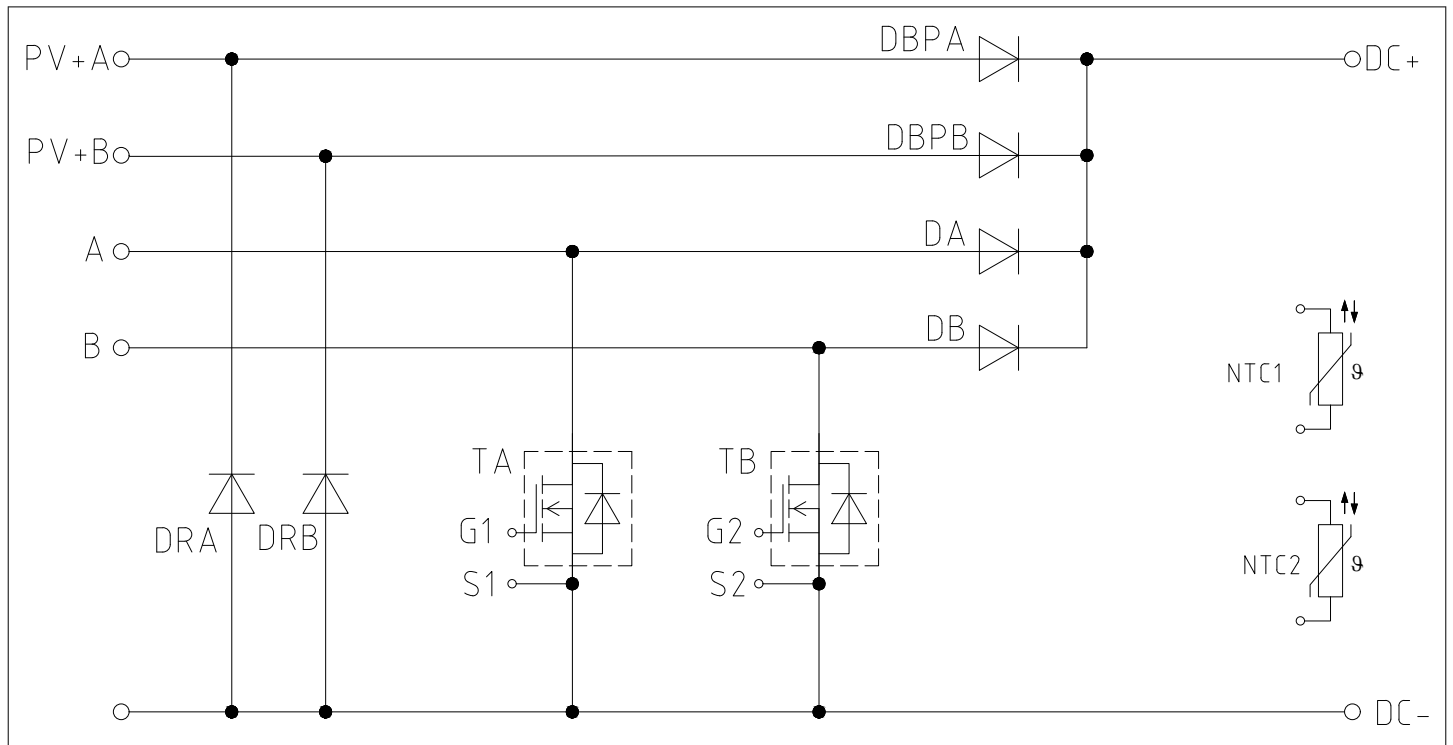


Abbildung 1

10 Gehäuseabmessungen

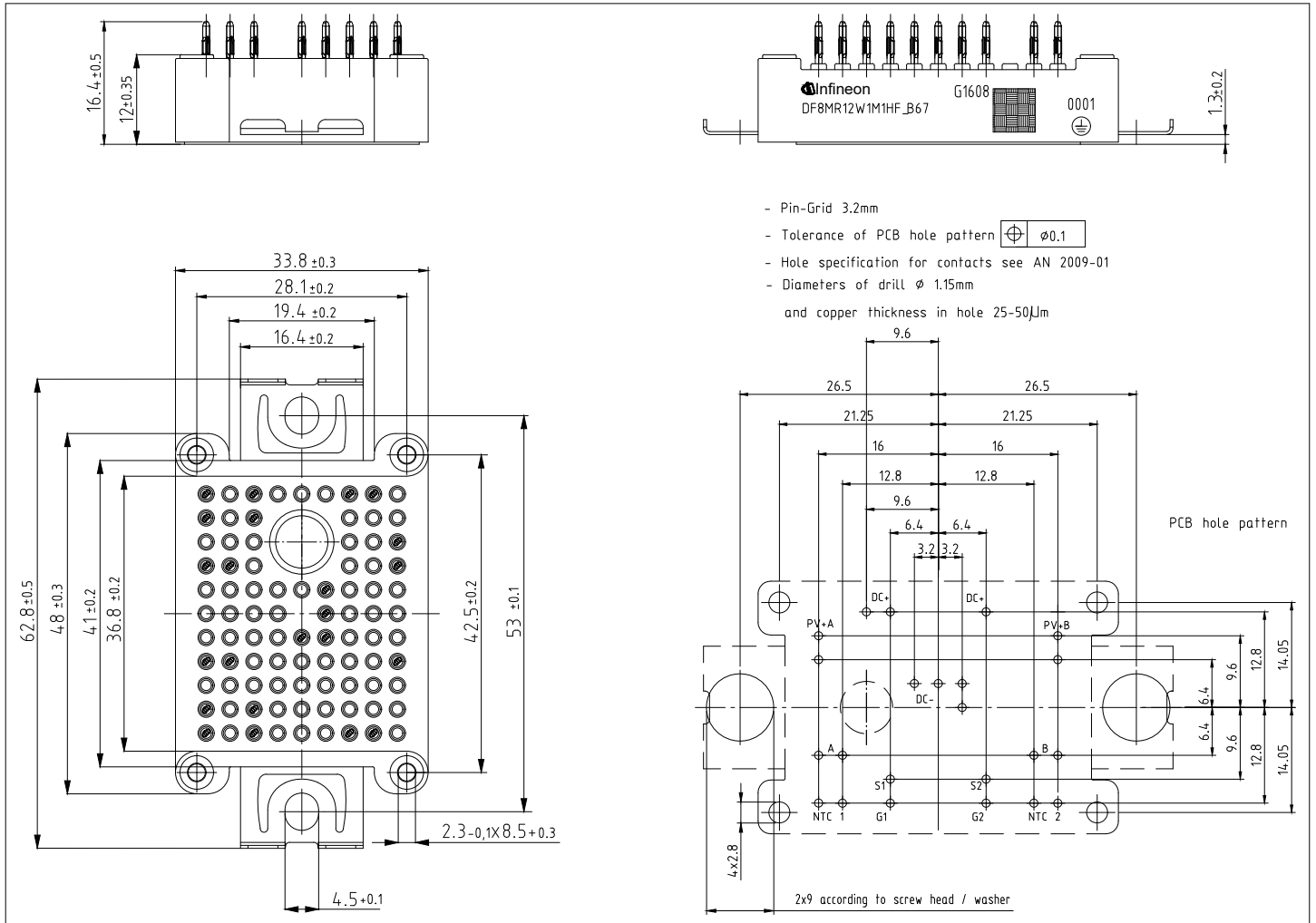


Abbildung 2

11 Modul-Label-Code


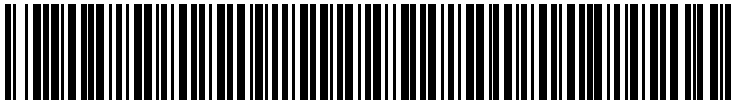
Module label code			
Code format	Data Matrix	Barcode Code128	
Encoding	ASCII text	Code Set A	
Symbol size	16x16	23 digits	
Standard	IEC24720 and IEC16022	IEC8859-1	
Code content	<i>Content</i> Module serial number Module material number Production order number Date code (production year) Date code (production week)	<i>Digit</i> 1 - 5 6 - 11 12 - 19 20 - 21 22 - 23	<i>Example</i> 71549 142846 55054991 15 30
Example	 		<p>71549142846550549911530</p> <p>71549142846550549911530</p>

Abbildung 3

Änderungshistorie

Dokumentenrevision	Freigabedatum	Beschreibung
0.10	2022-11-21	Initial version

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2022-11-21

Published by

**Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany**

**© 2022 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.**

**Do you have a question about any
aspect of this document?**

Email: erratum@infineon.com

**Document reference
IFX-ABE635-001**

Wichtiger Hinweis

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keinesfalls Garantien für die Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes ("Beschaffenheitsgarantie") dar.

Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben, die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen, ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Infineon Technologies ausgeschlossen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, die Gewähr dafür, dass kein geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen sämtliche, in diesem Dokument enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument

enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung obliegt den technischen Fachabteilungen des Kunden.

Warnhinweis

Aufgrund der technischen Anforderungen können Produkte gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte mit dem nächsten Vertriebsbüro von Infineon Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdrücklich in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument zugestimmt hat, dürfen Produkte von Infineon Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein Fehler des Produktes oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu Personenverletzungen führen.